

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-186557

(43)公開日 平成11年(1999) 7月9日

(51)Int.Cl.⁸

H 0 1 L 29/786
21/336

識別記号

F I

H 0 1 L 29/78

6 1 7 N

6 1 6 A

6 1 6 M

6 1 8 C

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全 7 頁)

(21)出願番号 特願平9-353880

(22)出願日 平成9年(1997)12月22日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 堀田 昌義

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 弁理士 平木 祐輔

(54)【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 薄膜トランジスタのドライブ能力を向上させて従来よりも大きなオン電流を持つスイッチング特性の改善された薄膜トランジスタを提供すること。

【解決手段】 本発明によれば、下部ゲート電極3aの側壁上に位置するようにポリシリコン薄膜のチャネル領域51を縦方向に配置して下部ゲート電極3aを取り囲むようにトランジスタを形成することでチャネル幅を増大することと、ゲート絶縁膜4、6を介してセルフアラインで下部ゲート電極3aを取り囲むようにサイドウォール状に形成した上部ゲート電極8aとのダブルゲート構造を用いることを特徴とする。

